

2SD721, 2SD722

■シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

☆2SB711、2SB712とコンプリメンタリペアになります。

☆ダーリントントランジスタ

☆レジンモールドケース

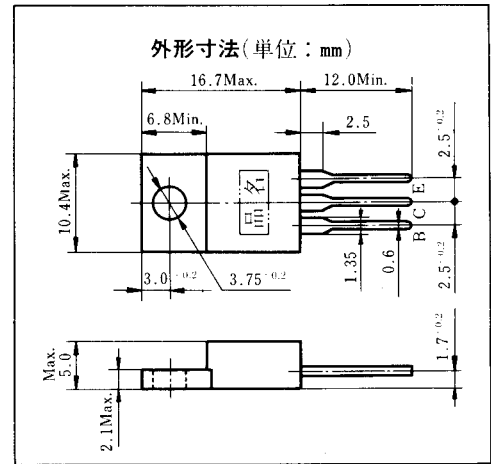
○一般用

○通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 2SD721 | 2SD722 |
|-------------|------------------|-------------------|--------|
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CB0} | 100 V | 120 V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CE0} | 80 V | 100 V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EB0} | 6 V | |
| コレクタ電流 | I _C | 6 A (*Pulse10A) | |
| ベース電流 | I _B | 1 A | |
| 許容コレクタ損失 | P _c | 50 W (フランジ温度25°C) | |
| 接合部温度 | T _j | 150°C | |
| 保存温度 | T _{stg} | -55 ~ +150°C | |

*Pulse:10mSec.以下, Duty cycle 50%以下



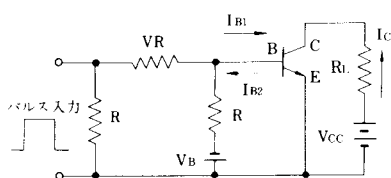
■電気的特性 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 試験条件 | 2SD721 | 2SD722 |
|-------------|----------------------|--|------------|--------|
| 最大コレクタしゃ断電流 | I _{CBO} | V _{CB} = | 100 μA | 100 μA |
| | | | 100 V | 120 V |
| 最大エミッタしゃ断電流 | I _{EB0} | V _{EB} = 6 V | 10 mA | |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CE0} | I _C = 10 mA | 80 V | 100 V |
| 直流電流増幅率 | h _{FE} | V _{CE} = 4 V I _C = 7 A | 500 Min. | |
| コレクタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C = 5 A I _B = 10 mA | 1.5 V Max. | |

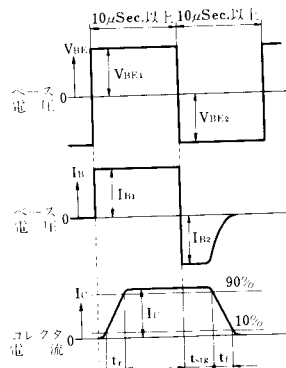
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

| V _{CC} (V) | R _L (Ω) | I _C (A) | I _{B1} (mA) | I _{B2} (mA) | t _r (μSec.) | t _{stg} (μSec.) | t _f (μSec.) |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 20 | 4 | 5 | 20 | -20 | 1.8 | 5.5 | 11 |

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

